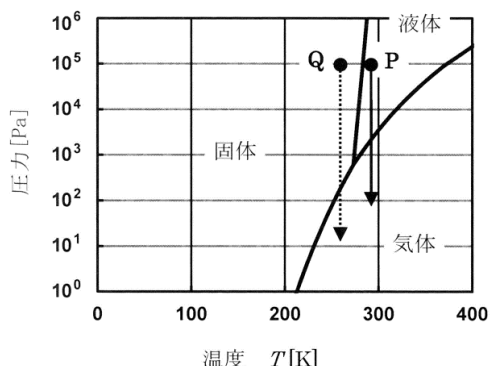
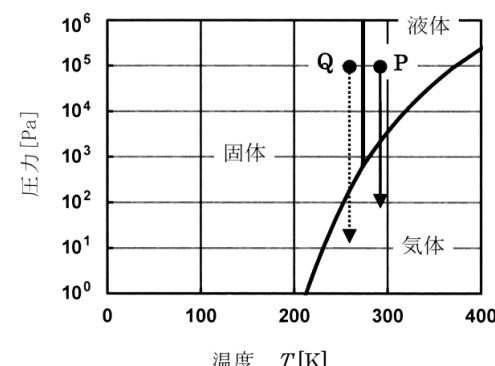


『最新 実用真空技術総覧』正誤表

この度は『最新 実用真空技術総覧』をご購入いただきまして、誠にありがとうございます。

本書の内容に以下の訂正箇所がございましたので、

訂正させていただきますとともに、深くお詫び申し上げます。

箇所		誤	正
執-v	下から8行目	横浜国立大学大学院工学研究院機能の創成部門	横浜国立大学大学院工学研究院機能の創生部門
執-vi	上から10行目	京都大学大学院工学研究科附属量子理工学研究センター	京都大学大学院工学研究科附属量子理工学教育研究センター
執-vi	下から14行目	東北大学工学研究科	東北大学大学院工学研究科
P.567	図2.1	 図2.1 水の状態図	 図2.1 水の状態図
P.570	図6.7 タイトル	基板温度が室温、400℃、および600℃である基板上に堆積されたTi薄膜の断面構造	基板温度が、200℃、400℃、および600℃である基板上に退席されたTi薄膜の断面構造
P.570	図6.8 タイトル	基板温度が室温、400℃、および600℃である基板上に堆積されたZr薄膜の断面構造	基板温度が、200℃、400℃、および600℃である基板上に退席されたZr薄膜の断面構造